

## ⑫ 公開特許公報(A) 平3-60134

⑤ Int. Cl.<sup>5</sup>H 01 L 21/52  
B 23 K 1/015

識別記号

C  
A

庁内整理番号

8728-5F  
6919-4E

⑬ 公開 平成3年(1991)3月15日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

⑭ 発明の名称 共晶系ソルダを用いたマウント方法

⑰ 特 願 平1-197112

⑱ 出 願 平1(1989)7月28日

⑲ 発 明 者 小 野 位 神奈川県伊勢原市板戸810

⑳ 発 明 者 阪 口 伸 一 神奈川県厚木市中町4-8-11 タミーハイツ

㉑ 出 願 人 ミツミ電機株式会社 東京都調布市国領町8丁目8番地2

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

共晶系ソルダを用いたマウント方法

## 2. 特許請求の範囲

半導体素子と基板間に共晶合金を挟持して上下治具により加圧保持し、これ等全体を不活性溶媒を加熱処理して得られる飽和蒸気中或いは加熱された不活性溶媒中に浸漬し、前記半導体素子と基板とを共晶合金を溶解し共晶拡散接合することを特徴とする共晶系ソルダを用いたマウント方法。

## 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体素子を基板に固着する際の共晶系ソルダを用いたマウント方法に関する。

(従来の技術)

従来、例えば、GaAs等の半導体素子がSi等による基板に固着されるに際して、第4図に示される様に、スパッタ等で形成され、メタライ

ズ処理した半導体素子2と基板3との間に共晶合金4が挟持され、且つ上部及び下部治具5、6に挟持されて加圧・加熱され、半導体素子2及び基板3が共晶合金を介して接合されていた。

斯かる接合にあっては、例えば、N<sub>2</sub>又はAr等の不活性ガスの雰囲気中で接合、即ち固着処理が行われていた。

(発明が解決しようとする課題)

上記従来の共晶合金を介するマウント方法に於いては、不活性ガスの雰囲気中での固着処理が行われるが、上部および下部治具5、6の加熱により酸化作用を生起し、又、上部及び下部治具5、6の温度管理が困難であるばかりか、半導体素子2と基板3の一面より加熱が行われるため熱伝動が均一化せず、温度のバラツキが生じ、そのため接合不良が生じたり、短時間に良好な接合状態が得られない等々の不都合を有していた。

本発明は係る点に鑑みてなされ、酸化作用を生起せず、又温度管理が容易であり、熱伝動が均一化して、短時間に良好な接合状態が得られる共

晶系ソルダを用いたマウント方法を提供することを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

上記目的を解決するために本発明に係る共晶系ソルダを用いたマウント方法は、半導体素子と基板間に共晶合金を挟持して上下治具により加圧保持し、これ等全体を不活性溶媒を加熱処理して得られる飽和蒸気中或いは加熱された不活性溶媒中に浸漬し、前記半導体素子と基板とを共晶合金を溶解し共晶拡散接合することを特徴とする。

〔作用〕

以上の共晶系ソルダを用いたマウント方法に於いては、フッ素化不活性溶媒の飽和蒸気層中或いは加熱された不活性溶媒中で共晶拡散接合を行なうため加熱による酸化作用がなく、溶媒の沸点以上に温度が上昇しないため熱的管理が容易であり、加熱される共晶合金の温度のバラツキがなく、更に、熱伝動が一面からでなく全面から加熱されることとなり短期間に均一に伝導して基板に半導体素子を緊密に接合できる。

熱吸収が行われて半導体素子10と基板13間の共晶合金12が溶解されて共晶拡散接合が行われる。

この場合、加圧治具14、15等を加熱する場合に比して、酸化作用がなく、又フッ素化不活性溶媒Pの沸点以上には、温度が上昇しないため温度の管理、例えば、共晶合金12の差異と半導体素子10、基板13のサイズの違い等に対する温度管理が容易になる。

このようにして熱媒体の凝縮熱の熱交換をもって共晶合金12を介して半導体素子10と基板13の接合が行われる。

次に、他の実施例として第3図に示される様に、フッ素化不活性溶媒P中に浸漬して、前記の様に半導体素子10と基板13を共晶合金12による共晶拡散の接合を行うこともできる。斯かる接合の状態も前記同様な作用効果を得ることができる。

尚、上記何れの実施例の場合に於いても、フッ素化不活性溶媒を使用するため、大気中でも利

〔実施例〕

以下、本発明に係る共晶系ソルダを用いたマウント方法の実施例を添付図面を参照して詳細に説明する。

第1図は本発明の実施例に於ける半導体素子、基板等の配置状態を示し、第2図及び第3図は飽和蒸気中及び溶媒中の浸漬状態での接合状態を示す。

第1図において、スパッタ等で形成され、メタライズ処理した半導体素子10と基板13との間に共晶合金による共晶系ソルダ12が配置される。次いで、半導体素子10と基板13上下の治具14及び15の間に挟持・加圧される。

次に、上記のように構成された後、その全体を第2図に示されるように、フッ素化不活性溶媒Pの容器Mを加熱して発生する飽和蒸気Va中に配置する。

斯かる飽和蒸気Va中でのマウント方法に於いては、フッ素化不活性溶媒Pの飽和蒸気Vaの熱が全面的に及ぶものとなり、それにより全体に

用できることとなり、従来例の場合の不活性ガスを利用する大型装置に比較し、手軽に活用できる利点がある。

〔発明の効果〕

以上のように本発明に係る共晶系ソルダを用いたマウント方法に於いては、半導体素子と基板間に共晶合金を挟持して上下治具により加圧保持し、これ等全体を不活性溶媒を加熱処理して得られる飽和蒸気中或いは加熱された不活性溶媒中に浸漬し、前記半導体素子と基板とを共晶合金を溶解し共晶拡散接合することにより、酸化作用を生起せず、又温度管理が容易であり、熱伝動が均一化して、短時間に良好な半導体素子と基体との接合状態が得られる効果を奏する。

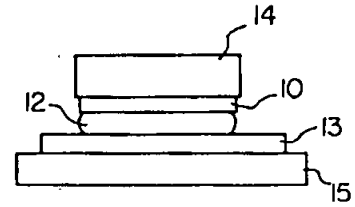
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の共晶系ソルダを用いたマウント方法の説明に供される図、第2図は飽和蒸気中での接合の説明状態図、第3図は溶媒に浸漬状態での接合状態を示す説明図、第4図は従来例による共晶系ソルダを用いたマウント方法の説明図

である。

10…半導体素子、 12…共晶系ソルダ、  
13…基板、 14、15…上下の治具、  
P…不活性溶媒、  
Va…飽和蒸気、

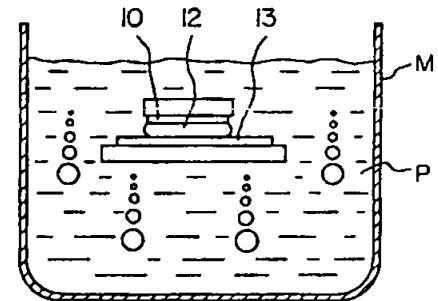
第 1 図



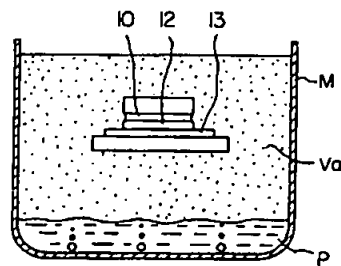
特許出願人 ミツミ電機株式会社  
代表者 森 郎



第 3 図



第 2 図



第 4 図

